ГЕНЕРАЦИЯ ЭКСИТОНОВ И ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА МОЛЕКУЛАМИ В ОБОЛОЧКЕ СЛОИСТОЙ КОМПОЗИТНОЙ НАНОСТРУКТУРЫ С ЗАМАГНИЧЕННОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ ЧАСТЬЮ

Кучеренко М.Г., Чмерева Т.М. Центр лазерной и информационной биофизики, Оренбургский государственный университет, г. Оренбург

При использовании слоистых композитных нанструктур в фотонике важным фактором управления их свойствами служит внешнее магнитное поле [1]. Наличие проводящих компонентов в структуре обусловливает магниточувствительность системы даже в отсутствие у нее ферро- или парамагнитных свойств. Это связано с зависимостью диэлектрической проницаемости электронной плазмы проводника от вектора индукции **В** внешнего магнитного поля [2]. В приближении холодной замагниченной плазмы тензор $\vec{\varepsilon}^{(i)}(\boldsymbol{\omega} | \mathbf{B})$ диэлектрической проницаемости в декартовой системе координат ($\mathbf{B} = B_z \mathbf{n}_z$) записывается в виде

$$\vec{\varepsilon}^{(i)}(\boldsymbol{\omega} \,|\, \mathbf{B}) = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\perp} & ig & 0\\ -ig & \varepsilon_{\perp} & 0\\ 0 & 0 & \varepsilon_{\parallel} \end{pmatrix},\tag{1}$$

где компоненты тензора

$$\varepsilon_{\perp}(\omega | \mathbf{B}) = 1 - \frac{\omega_p^2(\omega + i\gamma)}{\omega[(\omega + i\gamma)^2 - \Omega_L^2]}, \ \varepsilon_{\parallel} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\gamma)}, \ g(\omega | \mathbf{B}) = \frac{\omega_p^2 \Omega_L}{\omega[(\omega + i\gamma)^2 - \Omega_L^2]}$$
(2)

а параметры

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi e^2 n_e}{m}}$$
 – ленгмюровская (плазменная) частота, $\Omega_L = \frac{e |\mathbf{B}|}{mc}$ –

ларморовская (циклотронная) частота электрона в магнитном поле индукции В.

Тензоры, определяющие конфигурацию поля цилиндрического слоистого композита

Рассмотрим композитную слоистую систему с цилиндрической симметрией. Неполный анализ случая сферического композита проводился нами ранее в [3], но и он может быть полностью завершен по аналогии с решением задачи для цилиндрической системы, приведенным ниже.

Как и в случае слоистого шара, большой интерес для ряда приложений представляет тензор поляризуемости $\ddot{\mathbf{A}}(\omega | \mathbf{B})$ композита (в расчете на единицу его длины) в однородном поле \mathbf{E}_0 , посредством которого удобно производить

расчет характеристик ближнего поля снаружи цилиндра – у поверхности его внешнего слоя. Определим в цилиндрической системе координат (выбираем в качестве оси Z ось цилиндра) потенциалы $\Phi_j(r,\theta,z)$, j=1,2,3 поля во всех областях, отображенных на рис. 1. Выражения для этих потенциалов записываем по аналогии с ранее рассмотренным сферическим случаем и известной изотропной слоистой аксиальной системой, заменяя все скалярные коэффициенты изотропного случая их тензорными аналогами. Таким образом, подобно выражениям, приведенным в [3], можем записать



Рис. 1. Структура коаксиального слоистого нанокомпозита с проводящей жилой и диэлектрической оболочкой, помещенного в диэлектрическую среду с проницаемостью ε_3 .

$$\Phi_{1}(r,\theta,z) = -\ddot{\mathbf{B}}(\ddot{\varepsilon}_{1},\varepsilon_{2},\varepsilon_{3})\mathbf{E}_{0}\mathbf{r},$$
(3)

$$\Phi_{2}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{\theta},\boldsymbol{z}) = -\tilde{\mathbf{C}}(\boldsymbol{\ddot{\varepsilon}}_{1},\boldsymbol{\varepsilon}_{2},\boldsymbol{\varepsilon}_{3})\mathbf{E}_{0}\mathbf{r} + \tilde{\mathbf{D}}(\boldsymbol{\ddot{\varepsilon}}_{1},\boldsymbol{\varepsilon}_{2},\boldsymbol{\varepsilon}_{3})\mathbf{E}_{0}\mathbf{r} / \boldsymbol{r}^{2}, \qquad (4)$$

$$\Phi_{3}(r,\theta,z) = -\tilde{\mathbf{I}} \cdot \mathbf{E}_{0}\mathbf{r} + \tilde{\mathbf{A}}(\vec{\varepsilon}_{1},\varepsilon_{2},\varepsilon_{3})\mathbf{E}_{0}\mathbf{r} / r^{2}.$$
(5)

Соотношения между неизвестными тензорами $\ddot{\mathbf{A}}, \ddot{\mathbf{B}}, \ddot{\mathbf{C}}, \ddot{\mathbf{D}}$ находим из условий на граничных поверхностях (окружностях) $C(R_1)$ и $C(R_2)$:

$$\Phi_1(R_1,\theta) = \Phi_2(R_1,\theta), \quad \Phi_2(R_2,\theta) = \Phi_3(R_2,\theta),$$
 (6)

$$\vec{\varepsilon}_{1}(\omega) \left(\frac{\partial \Phi_{1}}{\partial r}\right)_{R_{1}} = \varepsilon_{2} \left(\frac{\partial \Phi_{2}}{\partial r}\right)_{R_{1}}, \quad \varepsilon_{2} \left(\frac{\partial \Phi_{2}}{\partial r}\right)_{R_{2}} = \varepsilon_{3} \left(\frac{\partial \Phi_{3}}{\partial r}\right)_{R_{2}}.$$
(7)

Тогда на основе (3)-(5) и (6)-(7) можем получить

$$\ddot{\mathbf{B}} = \ddot{\mathbf{C}} - \ddot{\mathbf{D}} / R_1^2, \quad -\ddot{\mathbf{C}} + \ddot{\mathbf{D}} / R_2^2 = -\ddot{\mathbf{I}} + \ddot{\mathbf{A}} / R_2^2, \tag{8}$$

$$\vec{\varepsilon}_{1}(\omega)\vec{\mathbf{B}} = \varepsilon_{2}\vec{\mathbf{C}} + \varepsilon_{2}\vec{\mathbf{D}}/R_{1}^{2}, \quad \varepsilon_{2}\vec{\mathbf{C}} + \varepsilon_{2}\vec{\mathbf{D}}/R_{2}^{2} = \varepsilon_{3}\vec{\mathbf{I}} + \varepsilon_{3}\vec{\mathbf{A}}/R_{2}^{2}.$$
(9)

Последовательно исключая из (8) и (9) посредством линейных $\mathbf{\ddot{D}}, \mathbf{\ddot{C}}, \mathbf{\ddot{B}},$ получаем преобразований тензоры для тензора A дипольной поляризуемости единицы длины слоистого композитного цилиндра c анизотропной жилой следующее выражение

$$\vec{\mathbf{A}}\left(\vec{\varepsilon}_{1}(\boldsymbol{\omega}|\mathbf{B}),\varepsilon_{2},\varepsilon_{3}\right) = \left[\left(\vec{\varepsilon}_{1}(\boldsymbol{\omega}|\mathbf{B})+\varepsilon_{2}\right)\left(\varepsilon_{2}-\varepsilon_{3}\right)+\left(\vec{\varepsilon}_{1}(\boldsymbol{\omega}|\mathbf{B})-\varepsilon_{2}\right)\left(\varepsilon_{2}+\varepsilon_{3}\right)\boldsymbol{\xi}^{2}\right]\times \\\times \left[\left(\vec{\varepsilon}_{1}(\boldsymbol{\omega}|\mathbf{B})+\varepsilon_{2}\right)\left(\varepsilon_{2}+\varepsilon_{3}\right)+\left(\vec{\varepsilon}_{1}(\boldsymbol{\omega}|\mathbf{B})-\varepsilon_{2}\right)\left(\varepsilon_{2}-\varepsilon_{3}\right)\boldsymbol{\xi}^{2}\right]^{-1}R_{2}^{2},$$
(10)

где $\xi = R_1 / R_2$. Тензор $\mathbf{\ddot{B}}(\mathbf{\ddot{\varepsilon}}_1, \mathbf{\varepsilon}_2, \mathbf{\varepsilon}_3)$, определяющий на основе (3) однородное поле в приосевой области может быть найден на основе следующего равенства

$$\left[\vec{\varepsilon}_{1}(\omega) + \varepsilon_{2}\vec{\mathbf{I}}\right]\vec{\mathbf{B}}(\omega) = -(\varepsilon_{2} - \varepsilon_{3})\vec{\mathbf{A}}(\omega) / R_{2}^{2} + (\varepsilon_{2} + \varepsilon_{3})\vec{\mathbf{I}}.$$
 (11)

Вектор **E**₁ напряженности однородного поля в приосевой области (в корде) композита, вообще говоря, не коллинеарен вектору **E**₁ = $\ddot{\mathbf{B}}(\vec{\varepsilon}_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)\mathbf{E}_0$.

Если проводящей в композите является оболочка, а корд – диэлектрический, действуя аналогичным образом для тензора $\ddot{\mathbf{A}}(\varepsilon_1, \vec{\varepsilon}_2(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_3)$ поляризуемости слоистого цилиндрического композита с замагниченной проводящей оболочкой получаем

$$\begin{split} \ddot{\mathbf{A}} \Big(\varepsilon_{1}, \ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_{3} \Big) &= \\ &= \Big[\Big(\varepsilon_{1} + \ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) \Big) \Big(\ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) - \varepsilon_{3} \Big) + \Big(\varepsilon_{1} - \ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) \Big) \Big(\ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) + \varepsilon_{3} \Big) \xi^{2} \Big] \times \quad (12) \\ &\times \Big[\Big(\varepsilon_{1} + \ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) \Big) \Big(\ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) + \varepsilon_{3} \Big) + \Big(\varepsilon_{1} - \ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) \Big) \Big(\ddot{\varepsilon}_{2}(\omega | \mathbf{B}) - \varepsilon_{3} \Big) \xi^{2} \Big]^{-1} R_{2}^{2}. \end{split}$$

Потенциал $\Phi_3(r,\theta)$ и напряженность $\mathbf{E}_3(r,\theta)$ поля вблизи слоистого цилиндрического композита с замагниченной оболочкой определяются выражениями

$$\Phi_{3}(r,\theta) = -\mathbf{\vec{I}} \cdot \mathbf{n}_{0} \mathbf{n}_{\theta} E_{0} r + \mathbf{\vec{A}}(\omega | \mathbf{B}) \mathbf{E}_{0} \mathbf{n}_{\theta} / r.$$
(13)
$$\mathbf{n}_{0} = \mathbf{E}_{0} / | \mathbf{E}_{0} |, \mathbf{n}_{\theta} = \mathbf{r} / | \mathbf{r} |,$$

$$\mathbf{E}_{3}(r,\theta) = \mathbf{E}_{0} - \vec{\nabla} \mathbf{\vec{A}}(\varepsilon_{1}, \mathbf{\vec{\varepsilon}}_{2}(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_{3}) \mathbf{E}_{0} \mathbf{r} / r^{2}.$$
(14)

Картина распределения напряженности поля $\mathbf{E}_{3}(r,\theta)$ для этого случая представлена на рис. 2 для двух различных частот ω и постоянном магнитном поле индукции **B**=10 Тл.

При выключении магнитного поля все тензорные величины редуцируются к своим скалярным прототипам и (10)-(12) трансформируются к выражениям для поляризуемостей изотропного слоистого композита [4]. Тогда скалярный фактор Лоренца $B(\omega)$ усиления поля в корде принимает вид

$$B(\omega) = \frac{\varepsilon_3 + \varepsilon_2(\omega)}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2(\omega)} + \frac{\varepsilon_3 - \varepsilon_2(\omega)}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2(\omega)} \Big[\Big(\varepsilon_1 + \varepsilon_2(\omega)\Big) \Big(\varepsilon_2(\omega) - \varepsilon_3\Big) + \Big(\varepsilon_1 - \varepsilon_2(\omega)\Big) \Big(\varepsilon_2(\omega) + \varepsilon_3\Big) \xi^2\Big]}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2(\omega)} \frac{\Big[\big(\varepsilon_1 + \varepsilon_2(\omega)\Big) \big(\varepsilon_2(\omega) + \varepsilon_3\Big) + \big(\varepsilon_1 - \varepsilon_2(\omega)\Big) \big(\varepsilon_2(\omega) - \varepsilon_3\Big) \xi^2\Big]}{\Big[\big(\varepsilon_1 + \varepsilon_2(\omega)\Big) \big(\varepsilon_2(\omega) + \varepsilon_3\Big) + \big(\varepsilon_1 - \varepsilon_2(\omega)\Big) \big(\varepsilon_2(\omega) - \varepsilon_3\Big) \xi^2\Big]}.$$
(15)

Если $\varepsilon_1 = \varepsilon_3 = 1$ (проводящая цилиндрическая оболочка в вакууме) из (15) получаем

$$B(\omega) = \frac{4\varepsilon_2(\omega)}{\left[\varepsilon_2(\omega) + 1\right]^2 - \left[\varepsilon_2(\omega) - 1\right]^2 \xi^2},$$
(16)

как и в задаче 3 главы 1 известного курса теоретической физики Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица [5].



индукции **B**=10 Тл для двух различных частот ω падающей волны. Замагниченная электронная плазма проводящей оболочки. Вектор индукции магнитного поля **B** || оси OZ, а **E**₀ || оси OY. R₂=50 нм, R₁=30 нм, $\gamma = 10^{12} \text{ c}^{-1}$, $\varepsilon_1 = 1$, $\varepsilon_3 = 1,2$; $\omega_p = 1,38 \cdot 10^{16} \text{ c}^{-1}$. Резонансные частоты $\omega_{res1} = 5,94 \cdot 10^{15} \text{ c}^{-1}$ и $\omega_{res2} = 1,22 \cdot 10^{16} \text{ c}^{-1}$.

Поглощение света молекулой вблизи поверхности слоистого наноцилиндра

Поглощение света молекулой в ближнем поле нанокомпозита, помещенного в однородное монохроматическое поле $\mathbf{E}_0 \exp(-i\omega t)$ будет определяться, в том числе, и той составляющей общего поля, которая

формируется в результате поляризации цилиндрического нанокомпозита. Как и в предыдущем разделе выделим три характерные пространственные области

1:
$$0 < r < R_1$$
, $\varepsilon_1(\omega)$, \mathbf{E}_1
2: $R_1 < r < R_2$, ε_2 , $\mathbf{E}_2(r,\theta)$
3: $R_2 < r$, ε_3 , $\mathbf{E}_3(r,\theta)$

в каждой из которых, диэлектрические проницаемости $\varepsilon_1(\omega), \varepsilon_2, \varepsilon_3$ не зависят от координат, а в материалах, заполняющих области 2 и 3, к тому же, отсутствует частотная дисперсия. Поле в центральной жиле композита однородно \mathbf{E}_1 =const, тогда как поля в оболочке и вне композита зависят от полярных координат (r, θ) точек областей 2 и 3.

Если молекула находится вблизи поверхности нанокомпозита (в его ближнем поле), а ее электронный дипольный момент перехода $\mathbf{p}_{if} = \langle i | \hat{\mathbf{p}} | f \rangle$ между основным *i* и возбужденным *f* состояниями известен, скорость $w(\omega | r, \theta)$ поглощения фотонов молекулярной системой будет определяться выражением [6]

$$w(\omega | r, \theta) = \frac{2\gamma}{\hbar^2} \frac{\left| \mathbf{p}_{if} \mathbf{E}_3(r, \theta) \right|^2}{\left[(\omega - \omega_{if})^2 + \gamma^2 \right]},$$
(17)

где $\mathbf{E}_3(r,\theta)$ – напряженность результирующего (локального) поля в точке расположения молекулы вне цилиндра с оболочкой ($R_2 < r$), определенная формулой, эквивалентной (14)

$$\mathbf{E}_{3}(r,\theta) = \mathbf{E}_{0} + \ddot{\mathbf{G}}_{2}(r,\theta) \ddot{\mathbf{A}}(\varepsilon_{1}(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_{2}, \varepsilon_{3}) \mathbf{E}_{0}, \qquad (18)$$

где $\ddot{\mathbf{G}}_{2}(r,\theta) = r^{-2}[2\mathbf{n} \otimes \mathbf{n} - \ddot{\mathbf{I}}]$ – двумерный тензор Грина квазистатического поля поляризованного цилиндра; ω_{if} – резонансная частота внутримолекулярного радиационного перехода $i \rightarrow f$; γ – ширина Лоренцева контура полосы поглощения молекулы. Другие максимумы в спектре поглощения (16) будут обусловлены плазмонными резонансами тензора $\ddot{\mathbf{A}}(\omega | \varepsilon_1(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ удельной поляризуемости композитного цилиндра. Второе слагаемое в правой части (18) определяет вклад поля двумерного диполя в напряженность $\mathbf{E}_3(r,\theta)$ суммарного поля вне цилиндра. Подчеркнем, что скорость поглощения фотонов (17), вслед за локальным полем (18), является магнитозависимой величиной.

В отсутствие магнитного поля дипольная поляризуемость единицы длины слоистого композитного цилиндра с осевой проводящей жилой из металла со скалярной диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_1(\omega)$ может быть записана в виде:

$$\alpha\left(\varepsilon_{1}(\omega),\varepsilon_{2},\varepsilon_{3}\right) = \frac{\left[\left(\varepsilon_{1}(\omega)+\varepsilon_{2}\right)(\varepsilon_{2}-\varepsilon_{3})+\left(\varepsilon_{1}(\omega)-\varepsilon_{2}\right)(\varepsilon_{2}+\varepsilon_{3})\xi^{2}\right]}{\left[\left(\varepsilon_{1}(\omega)+\varepsilon_{2}\right)(\varepsilon_{2}+\varepsilon_{3})+\left(\varepsilon_{1}(\omega)-\varepsilon_{2}\right)(\varepsilon_{2}-\varepsilon_{3})\xi^{2}\right]}R_{2}^{2}.$$
 (19)

Даже в простейшем случае бездисперсионной диэлектрической оболочки ее наличие в композите приводит к смещению частоты плазмонного резонанса для поляризуемости (19), что дает возможность плавной настройки поглощения энергии электромагнитного поля молекулой, размещенной на внешней поверхности слоистой наноструктуры.

Поглощение света молекулой, внедренной в оболочку композитного наноцилиндра. Трансформационные тензоры слоистого наноцилиндра

Если фотоактивная молекула инкорпорирована в оболочку композита, скорость поглощения ею энергии электромагнитного поля будет определяться не только эффективной поляризуемостью $\mathbf{\ddot{A}}(\omega|\varepsilon_1(\omega|\mathbf{B}),\varepsilon_2,\varepsilon_3)$ системы, а другими, более сложными трансформационными тензорами $\mathbf{\ddot{D}},\mathbf{\ddot{C}},\mathbf{\ddot{B}}$, связанными с тензором $\mathbf{\ddot{A}}$.

Тензор **В** уже был определен ранее равенством (11). Тензор **D** находим складывая равенства (8)

$$\ddot{\mathbf{D}} = \left[\ddot{\mathbf{B}} - \ddot{\mathbf{I}} + \ddot{\mathbf{A}} / R_2^2 \right] \left[1 / R_2^2 - 1 / R_1^2 \right]^{-1}.$$
(20)

Наконец для тензора С получаем

$$\ddot{\mathbf{C}} = \ddot{\mathbf{B}} + \ddot{\mathbf{D}} / R_1^2.$$
(21)

Локальное поле $\mathbf{E}_2(r, \theta)$ внутри оболочечного слоя неоднородно и определяется выражением

$$\mathbf{E}_{2}(r,\theta) = \vec{\nabla} \Big[\ddot{\mathbf{C}}(\varepsilon_{1}(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_{2}, \varepsilon_{3}) - \ddot{\mathbf{D}}(\varepsilon_{1}(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_{2}, \varepsilon_{3}) / r^{2} \Big] \mathbf{E}_{0}\mathbf{r}, \qquad (22)$$

где тензоры $\ddot{\mathbf{C}}(\varepsilon_1(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ и $\ddot{\mathbf{D}}(\varepsilon_1(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ связаны друг с другом соотношением (21), а тензор **B** определен равенством (11).

Заметим, что все трансформационные тензоры **В**, **Č**, **D** (как и тензор поляризуемости $\vec{A}(\omega | \varepsilon_1(\omega | \mathbf{B}), \varepsilon_2, \varepsilon_3)$) зависят от индукции внешнего магнитного поля. Скорость $w(\omega | R_2 > r > R_1, \theta)$ поглощения фотонов молекулами, внедренными в диэлектрическую оболочку цилиндрического нанокомпозита будет по-прежнему определяться выражением (17), однако

вместо поля $\mathbf{E}_3(r, \theta | \mathbf{B})$ в нем теперь должна фигурировать величина $\mathbf{E}_2(r, \theta | \mathbf{B})$ – напряженность локального электрического поля в точке расположения молекулы внутри оболочечного слоя $R_2 > r > R_1$.

Поглощение света молекулами и скорость генерация экситонов Френкеля в оболочечном слое молекулярных J – агрегатов композитного наноцилиндра

В случае, когда проводящий наноцилиндр окружен оболочкой из органических молекул (например, цианиновых красителей), сгруппированных в Ј-агрегаты, образуется квазикристаллический слой, представляющий собой однородно поглощающую свет систему, с генерацией в этом слое экситонов Френкеля. В этом случае, скорость $w(\omega | R_1, R_2)$ поглощения фотонов оболочкой цилиндрического нанокомпозита будет определяться интегралом от квадрата напряженности $\mathbf{E}_2(r, \theta)$ локального поля в слое толщиной $\Delta R = R_2 - R_1$ [4]

$$w(\omega | R_1, R_2) = \frac{\omega}{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \operatorname{Im} \varepsilon_2(\omega) \left| \mathbf{E}_2(r, \theta | \omega) \right|^2 \pi d\theta \, r dr \,.$$
(23)



Рис. 3. Картина распределения напряженности ближнего поля вне слоистого поляризован-ного наноцилиндра с оболочкой из молекулярных J-агрегатов и замагниченной электронной плазмой проводящего корда. Индукция магнитного поля B=10 Тл, B || оси ОZ, E₀ || оси ОY. R₂=50 нм, R₁=30 нм, $\gamma = 10^{12} \text{ c}^{-1}$, $\Omega^2 F = 3 \cdot 10^{15} \text{ c}^{-1}$, $\omega_{res}(0) = 4,61 \cdot 10^{15} \text{ c}^{-1}$, $\Gamma = 10^{11} \text{ c}^{-1}$

Диэлектрическая проницаемость ε_2 покрывающего слоя в этом случае имеет сильную частотную зависимость, обусловленную наличием экситонных мод в кристаллоподобном материале оболочки [7]

$$\varepsilon_2(\omega) = \varepsilon_0 - \frac{\Omega^2 F}{\left[\omega + i\Gamma(\omega)\right]^2 - \omega_{res}^2(0)},$$
(24)

где ε_0 – диэлектрическая проницаемость, обусловленная всеми другими состояниями электронов, кроме экситонных состояний; $\Gamma(\omega)$ – скорость релаксации, обусловленная взаимодействием экситонов с фононами; Ω^2 – квадрат «плазменной частоты» электронов оболочечного слоя; F – сила осциллятора экситонного перехода; $\omega_{res}(0)$ – частота середины экситонной зоны – с нулевым волновым вектором **k**. Далее в расчетах использовались значения частотных параметров экситонов, характерные для органических молекулярных кристаллов: $\Omega^2 F = 3 \cdot 10^{15} \text{ c}^{-1}$, $\Gamma = 10^{11} - 10^{14} \text{ c}^{-1}$, $\omega_{res}(0) = 10^{15} \text{ c}^{-1}$ [7]. Заметим, что использование для расчетов скорости поглощения композитом энергии инициирующего поля Е₀ мнимой части удельной поляризуемости Im $\alpha(\omega | \varepsilon_1(\omega), \varepsilon_2(\omega), \varepsilon_3)$ дает величину *полной* скорости поглощения, с учетом и той части энергии, которая диссипирует в металле композита при затухании его плазмонных мод. С другой стороны, выражение (23) учитывает лишь инициирующего поля оболочкой поглошение энергии композита непосредственно дает скорость генерации экситонов в ней. В качестве примера на рис. 3 представлены карты распределения напряженности ближнего поля вне слоистого поляризованного наноцилиндра с оболочкой из молекулярных Jагрегатов и замагниченной электронной плазмой (В=10 Тл) проводящего корда для двух различных частот ω , близких к резонансным. Высокочастотный резонанс может считаться условно плазмонным, и именно для него влияние магнитного поля является наиболее отчетливо выраженным [8].

В спектре поляризуемости $Im(\alpha)$ проводящего цилиндра с диэлектрической оболочкой, на плазмонной частоте возникает резонанс, обусловленный воздействием электрического поля волны на металлическую сердцевину композита. В том случае, когда металлическая жила покрыта слоем молекулярных J-агрегатов, кроме плазмонного пика в диапазоне частот 0.6ё 0.65 ω_n , в низкочастотной области спектра возникают два экситонных резонанса [8]. С увеличением радиуса проводящей жилы, плазмонный резонансный пик увеличивается по амплитуде и смещается с высокочастотную область. Кроме того, с увеличением силы осциллятора экситонного перехода спектральная амплитуда удельной поляризуемости композита в области экситонной полосы увеличивается, а в области плазмонной полосы уменьшается, при этом экситонные резонансы расходятся по частоте относительно друг друга с большим размахом, нежели плазмонные [8]. С увеличением частоты перехода, отвечающей центру экситонной зоны, экситонная полоса удельной поляризуемости, в свою очередь, смещается в высокочастотную область, при этом происходит и незначительное смещение максимума плазмонной полосы в том же направлении.

Таким образом, в работе получено точное решение задачи о поглощении энергии электромагнитного поля молекулами и кристаллоподобными молекулярными агрегатами, образующими внешнюю оболочку протяженного проводящего наноцилиндра при наличии внешнего магнитного поля. Приведены аналитические выражения для дипольной поляризуемости композитного электронной наноцилиндра С замагниченной плазмой металлического компонента в прозрачной стеклообразной среде. Учитывалось, что в кристаллоподобных молекулярных оболочках слоистых цилиндров возникают экситоны Френкеля, обусловливающие появление новых резонансов в функции отклика. Дальнейшая безызлучательная трансформация экситонов в аксиально-симметричной системе может быть рассмотрена с помощью методов, изложенных в [9], где проведен анализ релаксации экситонов Ваннье-Мотта в полупроводниковых квантовых нитях.

Авторы благодарны Г.С. Коловертнову за помощь в проведении расчетов полей нанокомпозитов. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и правительства Оренбургской области (проект № 16-42-560671), а также Министерства образования и науки РФ (Госзадание № 233).

Список литературы

1. Kucherenko, M.G. Dynamics and relaxation of excited molecular states in local field of composited nanoparticles and external magnetic field / M.G. Kucherenko // Russian-Japanese Conference «Chemical Physics of Molecules and Polyfunctional Materials»: Proceedings. OSU. Orenburg. IPK «Universitet». 2014. – P.13-15.

2. Гинзбург, В.Л. Волны в магнитоактивной плазме / В.Л. Гинзбург, А.А. Рухадзе // М.: Наука. 1975. -256 с.

3. Кучеренко, М.Г. Локализованные плазмоны в замагниченном наноцилиндре и сферическом слоистом композите с анизотропной сердцевиной или оболочкой / М.Г. Кучеренко // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всероссийской научно-методической конференции. Оренбургский гос. ун-т. – Электрон. дан. – Оренбург: ОГУ, 2016. – С. 1220-1227.

4. Кучеренко, М.Г. Трансформация энергии в цилиндрической наноструктуре из металлической жилы и коаксиальной оболочки с молекулами люминофора / М.Г. Кучеренко, Т.М. Чмерева // Журнал приклад. спектр.2017.

5. Ландау, Л. Д. Электродинамика сплошных сред. Теоретическая физика. Т.8. / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц // М.: Физматлит. 2010. – 656 с.

6. Kucherenko, M.G. Absorption and spontaneous emission of light by molecules near metal nanoparticles in external magnetic field / M.G. Kucherenko, V.M. Nalbandyan // Physics Procedia 73 (2015) 136 – 142. doi: 10.1016/j.phpro.2015.09.134 © 2015 The Authors. Published by Elsevier B.V.

7. Давыдов, А.С. Теория твердого тела / А.С. Давыдов. // М.: Наука, 1976. –640 с.

8. Кучеренко, М.Г. Трансформация спектров удельной поляризуемости слоистых нанопроволок в магнитном поле / М.Г. Кучеренко, В.М. Налбандян // Универ. комплекс как регион. центр образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф. (с междунар. участием), 1-3 февр. 2017 г., Оренбург / Оренбург. гос. ун-т. – Электрон. дан. – Оренбург , 2017. (Настоящий сборник).

9. Кучеренко, М.Г. Экситон-плазмонное взаимодействие в системе «полупроводниковая квантовая нить - сферическая металлокомпозитная наночастица» / М.Г. Кучеренко, Т.М. Чмерева // В сб.: Универ. комплекс как рег. центр образования, науки и культуры. Матер. Всеросс. научно-метод. конфер. Оренбург. 2015. С. 1097-1106.